



⑯ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑯ Offenlegungsschrift
⑯ DE 100 11 005 A 1

⑯ Int. Cl.⁷:
H 01 L 23/50
H 01 L 21/60
H 01 L 25/065
H 01 L 23/12

⑯ Aktenzeichen: 100 11 005.3
⑯ Anmeldetag: 7. 3. 2000
⑯ Offenlegungstag: 18. 1. 2001

DE 100 11 005 A 1

⑯ Unionspriorität:

991125402 01.07.1999 EP

⑯ Anmelder:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

⑯ Vertreter:

Schoppe, Zimmermann & Stöckeler, 81479 München

⑯ Erfinder:

Landesberger, Christof, Dipl.-Phys., 81241 München, DE; Reichl, Herbert, Prof. Dr.-Ing., 14193 Berlin, DE; Ansorge, Frank, Dr.-Ing., 81245 München, DE; Ramm, Peter, Dr., 85276 Pfaffenhofen, DE; Ehrmann, Oswin, Dipl.-Phys., 13505 Berlin, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑯ Multi-Chip-Modul und Verfahren zum Herstellen eines Multi-Chip-Moduls

⑯ Ein Multi-Chip-Modul umfaßt einen Basis-Chip, einen Top-Chip, dessen Dicke kleiner als 100 μ m ist, sowie eine Klebeschicht, die zwischen dem Basis-Chip und dem Top-Chip angeordnet ist und die beiden Chips mechanisch miteinander verbindet. Eine elektrisch isolierende Planarisierungsschicht wird vorgesehen, um eine planare Oberfläche zu erhalten, derart, daß der Top-Chip in die Planarisierungsschicht eingebettet ist. Ein Durchgangsloch in der Planarisierungsschicht ist mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllt und einerseits mit einer Anschlußfläche des Basis-Chips in Verbindung und andererseits über eine Metallisierung mit einer Anschlußfläche des Top-Chips elektrisch leitfähig verbunden. Durch Durchgangslöcher in der Planarisierungsschicht, die mit elektrisch leitfähigem Material gefüllt sind, können sämtliche Verbindungen zwischen den Chips, zwischen dem Basis-Chip und einem äußeren Kontakt des Multi-Chip-Moduls oder zwischen dem Top-Chip und einem äußeren Kontakt des Multi-Chip-Moduls unabhängig von den einzelnen Chips und unter Verwendung üblicher Halbleiterprozeßschritte für planare Oberflächen hergestellt werden.

E 100 11 005 A 1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf integrierte Schaltungen und insbesondere auf dreidimensionale Multi-Chip-Module.

Chip-Systeme, die aus mehrere miteinander integrierten Einzelchips bestehen, werden allgemein als Multi-Chip-Module bezeichnet. Hierbei werden üblicherweise mehrere Chips auf ein Substrat gesetzt, das für alle Chips die Verdrahtungswege bereitstellt. Für die elektrischen Kontakte werden üblicherweise Drahtbondverbindungen und/oder Flip-Chip-Montagetechniken eingesetzt. Dieses zusammengesetzte Multi-Chip-Modul wird dann üblicherweise in ein vergleichsweise großes Gehäuse montiert, das Außenanschlüsse aufweist. Die Verdrahtung zwischen den inneren Anschlußflächen des Multi-Chip-Moduls und den äußeren Anschlußflächen werden dabei üblicherweise ebenfalls unter Verwendung von Bonddrähten realisiert.

Drahtbondverbindungen haben allgemein den Nachteil, daß sie nicht hochfrequenzfähig sind, da Bonddrähte bei hohen Frequenzen erheblichen Serieninduktivitäten darstellen und somit einen ausgeprägten Tiefpaßcharakter haben. Darüberhinaus ist das Drahtboden insbesondere wenn viele Bonddrähte hergestellt werden müssen, außerordentlich zeitaufwendig und damit teuer.

Flip-Chip-Techniken mit Lotkugeln oder aber mit anisotrop leitfähigen Klebermaterialien erfordern hohe Prozeßtemperaturen, welche 200°C übersteigen können. Darüberhinaus sind relativ lange Zykluszeiten angezeigt. Durch die hohen Temperaturen werden ebenfalls unerwünscht hohe thermomechanische Spannungen im Chip-Verbund eingebaut. Schließlich sind Flip-Chip-Montagetechniken nicht zu mehrlagigen Chip-Stapeln erweiterbar.

Ein weiterer wesentlicher Nachteil bei solchen Multi-Chip-Modulen ist die Tatsache, daß bereits im Schaltungsdesign des Substrats oder aber im Falle von mehrlagigen Chipstapeln im Schaltungsdesign der einzelnen Chips auf eine spätere dreidimensionale Integrationstechnik geachtet werden muß. Dies ist erforderlich, damit die geometrische Anordnung korrespondierender Anschlußflächen sichergestellt ist. Diese Voraussetzung ist besonders dann nachteilig, wenn das gesamte Multi-Chip-Modul eine sogenannte "Second-Source"-Anforderung erfüllen muß.

Der Grundgedanke von Multi-Chip-Modulen besteht darin, daß Chips, in denen verschiedene Funktionalitäten integriert sind, miteinander verdrahtet werden, um einen Chip eines Herstellers für eine bestimmte Funktion und einen Chip eines anderen Herstellers für eine andere Funktion verwenden zu können. Dieses Konzept ermöglicht den Rückgriff auf preisgünstig verfügbare Standardchips eines Herstellers oder aber verschiedener Hersteller. Damit ist es nicht mehr erforderlich, alle Funktionalitäten in einem einzigen Chip zu integrieren, was für vielerlei Anwendungen viel zu aufwendig ist.

Wenn an ein Multi-Chip-Modul gedacht wird, das eine Vielzahl von einzelnen Chips umfassen soll, ist jedoch die Abhängigkeit von den einzelnen Chip-Herstellern beachtlich. Ist nur ein einziger Chip von z. B. 10 Chips eines Multi-Chip-Moduls nicht mehr verfügbar, so muß bei bekannten Multi-Chip-Modulen, bei denen eine Basis sämtliche Verdrahtungswege und Kontaktanschußflächen bereitstellt, völlig neu entworfen werden, um an die anderen Anschlußkontakte geometrien eines Chips von einem anderen Hersteller angepaßt zu sein.

Derselbe Nachteil tritt ein, wenn festgestellt wird, daß ein Chip, der eine bestimmte Funktionalität implementiert, von einem Konkurrenzhersteller wesentlich günstiger produziert wird als von einem anderen Hersteller. Bei bekannten Multi-

Chip-Modulen wurde daher oftmals der teurere Chip weiter eingebaut, um nicht ein komplett neues Schaltungsdesign durchführen zu müssen, dessen Preis den Preisvorteil des billigeren Chips bei weitem übersteigen hätte.

5 Die Second-Source-Anforderung besteht somit darin, für möglichst viele Anwendungen vorprozessierte Chips, die fertig erworben werden können, einsetzen zu können. Dies ermöglicht Unabhängigkeit von einem einzelnen Chiphersteller und ermöglicht auch Flexibilität, preisgünstigere Chips konkurrierender Chiphersteller auswählen zu können.
 10 So haben Untersuchungen gezeigt, daß beispielsweise bei einfachen Silizium-Schaltungsschips bis zu 90% der Wertschöpfung des späteren Produkts im Bereich der Aufbau- und Verbindungstechniken liegen, aber nicht bei der Herstellung des Wafers, aus dem die einzelnen Chips durch Ver einzeln erzeugt werden können. Schließlich ermöglicht ein konsequentes Multi-Chip-Modul-Konzept, daß sich ein Schaltungsentwickler nicht mehr so sehr auf die einzelnen Funktionalitäten der verschiedenen Chips konzentrieren muß, sondern lediglich noch auf die Verschaltung der einzelnen Chipkomponenten untereinander.

Eine generelle Anforderung bei Multi-Chip-Modulen besteht ferner darin, ein Endprodukt zu erhalten, das ein kleines Volumen hat, und das darüberhinaus möglichst preisgünstig hergestellt werden kann, was wiederum bedeutet, daß keine aufwendigen neuen Herstellungsverfahren entwickelt werden müssen, sondern daß so weit als möglich auf bekannte Standardherstellungsprozesse zurückgegriffen werden kann.

25 20 30 Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Multi-Chip-Modul-Konzept zu schaffen, das zum einen flexibel ist und zum anderen preisgünstig realisierbar ist.

Diese Aufgabe wird durch ein Multi-Chip-Modul nach Patentanspruch 1 oder durch ein Verfahren zum Herstellen eines Multi-Chip-Moduls nach Patentanspruch 10 gelöst.

35 Der vorliegenden Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß ein preisgünstiges und flexibles Multi-Chip-Modul-Konzept dadurch realisiert werden kann, daß auf einem Basis-Chip mit üblichen Dimensionen zumindest ein Top-Chip unter Verwendung einer Klebeschicht aufgebracht wird, wobei der Top-Chip ein dünner Chip ist, dessen Dicke kleiner als 100 µm ist. Es wird bevorzugt, Top-Chips einzusetzen, deren Dicke sogar kleiner als 50 µm ist und insbesondere im Bereich von 20 µm und darunter liegen kann.

40 45 50 Im Gegensatz zu bekannten Verfahren wird beim erfindungsgemäßen Multi-Chip-Modul-Konzept der dünne Top-Chip auf einem passiven Bereich des Basis-Chips aufgebracht, so daß der Basis-Chip und der Top-Chip unabhängig voneinander entworfen sein können und somit auch entsprechend der Second-Source-Anforderung beliebige ausgetauscht werden können, da keine geometrisch korrespondierenden Kontaktanschußflächen vorhanden sein müssen. Aufgrund der Verwendung der superdünnen Chips ist es möglich, nach dem Aufkleben des Top-Chips auf den Basis-Chip den Chipverbund unter Verwendung einer Planarisierungsschicht zu planarisieren, um dann sämtliche Verbindungen zwischen dem Top-Chip und dem Basis-Chip und/oder von dem Top-Chip oder dem Basis-Chip nach außen über entsprechende Durchgangslöcher, welche mit leitfähigem Material gefüllt sind, durch die Planarisierungsschicht hindurch auszuführen.

55 60 65 Die Kontaktanschußflächen sowohl des Basischips als auch des Top-Chips können somit über entsprechende Durchgangslöcher durch die Planarisierungsschicht gewissermaßen nach oben herausgeführt werden, um dann unter Verwendung einer üblichen Lithographietechnologie beliebige Kontaktstrukturen herzustellen, durch die der Top-Chip und der Basis-Chip miteinander verbunden werden können.

oder durch die der Top-Chip für sich bzw. der Basis-Chip für sich von außen kontaktiert werden können.

Aufgrund der Tatsache, daß das Multi-Chip-Modul nach dem Planarisieren eine im wesentlichen planare Oberfläche hat, sind sämtliche für planare Oberflächen geeignete Prozeßtechnologien einsetzbar. Andererseits ermöglicht der Einsatz der dünnen Top-Chips, daß Durchgangslöcher durch die Planarisierungsschicht mit begrenztem Aufwand hergestellt werden können und darüberhinaus zuverlässig mit Metall gefüllt werden können, um die Anschlußflächen nach oben herauszuführen. Da die Dicke der Top-Chips kleiner als 100 µm ist und bis zu unter 20 µm betragen kann, sind die Aspektverhältnisse der erforderlichen Durchgangslöcher derart, daß eine zuverlässige Prozessierung mit üblichen Prozeßtechnologien möglich ist.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die auftretende Volumenminimierung. Jeder zusätzlich aufgebrachte Chip trägt nur einen dünnen Film zum Bauelementevolumen bei. Das komplette Multi-Chip-Modul ist letztlich nicht größer als ein Standard-IC. Diese Eigenschaft führt zu einem weiteren Vorteil, der darin besteht, daß das Multi-Chip-Modul unter Verwendung sämtlicher bekannter Anschlußtechniken weiter verarbeitet werden kann, wie z. B. durch Flip-Chip-Technologien oder aber über Bonddrähte.

Ein weiterer Vorteil, der zu einer wesentlichen Preisreduzierung führt, besteht darin, daß alle Kontaktierungs- und Verdrahtungs-Prozeßschritte auf einem Basis-Wafer als Träger stattfinden, wobei der Basis-Chip ein Teil des Basis-Wafers ist. Ein Großteil der Aufbau- und Verbindungstechnik kann somit bereits in der Waferfabrik sehr kostengünstig gefertigt werden. Das arbeitsintensive und zeitintensive Bonden zwischen den Chips des Moduls selbst oder zwischen den Chips des Moduls und äußeren Anschlußflächen entfällt.

Schließlich sind die Prozesse der "Chip-Montage" und der "Chip-Kontaktierung" getrennt. Die Montage der einzelnen dünnen Top-Chips des MCM-Moduls erfolgt in einem einfachen und schnellen Bestückungsprozeß vorzugsweise bei Raumtemperatur. Das Verkleben, d. h. das Härteln der Klebeschicht unterhalb der Top-Chips, erfolgt bei niedrigen Temperaturen zwischen 30 und 130°C. Es wird eine ganzflächige und homogene Verklebung erreicht. Die Trennung von Montage und Kontaktierung ermöglicht daher eine spannungsarme Aufbauweise, die zusätzlich wesentlich kleinere Taktzeiten mit sich bringt, als sie bei Flip-Chip-Techniken oder Drahtbondtechniken zu finden sind.

Die Technik zur Herstellung der Multi-Chip-Module kann ohne Zusatzaufwand zur Realisierung von mehrlagigen Chip-Verdrahtungsebenen erweitert werden.

Schließlich ist eine beliebige Auswahl der Chip-Komponenten möglich. Die Multi-Chip-Modul-Technik gemäß der vorliegenden Erfindung, bei der die gesamte Verdrahtung in der Planarisierungsschicht, also neben den Top-Chips stattfindet, ist tatsächlich unabhängig von den Einzel-Chip-Komponenten. Bereits existierende Schaltungswafer aus beliebiger Produktion können damit sofort dieser Integrations-technik zugeführt werden, ohne daß die Schaltungswafer selbst wieder umentwickelt werden müssen.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend bezugnehmend auf die beiliegenden Zeichnungen detailliert erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Multi-Chip-Modul gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit einer Bond-Anschlußfläche;

Fig. 2 ein Multi-Chip-Modul gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit Lotkugeln für eine Flip-Chip-Montage; und

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein Multi-Chip-Modul gemäß

der vorliegenden Erfindung mit zwei Top-Chips vor der Vereinzelung des Basis-Wafers, um die einzelnen Multi-Chip-Module zu erhalten.

In **Fig. 1** ist ein Multi-Chip-Modul gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung gezeigt. Dasselbe umfaßt einen Basis-Chip 10, der ein Halbleitersubstrat 10a und einen aktiven Bereich 10b aufweist, wobei der aktive Bereich 10b bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ein CMOS-Bereich ist. Auf der Oberfläche des Basis-Chips 10 ist eine Passivierungsschicht 12 aufgebracht, die von Anschlußflächen 14 durchbrochen ist, um den Basis-Chip 10 je nach Anwendung zu kontaktieren.

Das Multi-Chip-Modul, das in **Fig. 1** gezeigt ist, umfaßt ferner einen Top-Chip 16, der ebenfalls ein Halbleiter-Substrat 16a und beim hier bevorzugten Ausführungsbeispiel einen CMOS-Bereich 16b umfaßt. Der Top-Chip 16 hat ferner an seiner Oberseite eine Passivierungsschicht 18, die über einer Anschlußfläche 20 durchbrochen ist. Der Top-Chip 16 ist über eine Klebeschicht 22 mit der Passivierungsschicht 12 des Basis-Chips verbunden, derart, daß der Top-Chip 16 und der Basis-Chip 10 über die Klebeschicht 22 mechanisch verbunden sind. Der Top-Chip 16 ist in einer elektrisch isolierenden Planarisierungsschicht 24 eingebettet. Die elektrisch isolierende Planarisierungsschicht 24 bedeckt die Bereiche der Passivierungsschicht 12, in denen der Top-Chip 16 nicht angeordnet ist. Die Planarisierungsschicht 24 erstreckt sich zunächst über alle Anschlußflächen des Basis-Chips 10.

Bei dem in **Fig. 1** gezeigten Ausführungsbeispiel ist der Top-Chip 16 vollständig in die Planarisierungsschicht 24 eingebettet. Dies bedeutet, daß sich die Planarisierungsschicht 24 auch über den Top-Chip 16 hinweg erstreckt. Alternativ könnte die Planarisierungsschicht 24 jedoch auch derart ausgeführt sein, daß sie bündig zu der Planarisierungsschicht 18 des Top-Chips ist, wobei in diesem Fall die Anschlußfläche 20 des Top-Chips unmittelbar freiliegen würde und nicht durch die Planarisierungsschicht 24 bedeckt wäre.

Zum Herausführen von zumindest einigen der Anschlußflächen 14 des Basis-Chips wird in der Planarisierungsschicht 24 eine Mehrzahl von Durchgangslöchern 26a, 26b gebildet, welche mit leitfähigem Material gefüllt sind.

Für den in **Fig. 1** gezeichneten Fall, bei dem die Planarisierungsschicht 24 den Top-Chip 16 vollständig einbettet, wird ferner ein weiteres Durchgangsloch 28 gebildet, das sich jedoch nicht bis zum Basis-Chip erstreckt, sondern lediglich durch den oberhalb des Top-Chips vorhandenen Bereich der Planarisierungsschicht bis zur Anschlußfläche 20 des Top-Chips 16 erstreckt. Auch dieses Durchgangsloch 28 ist mit leitfähigem Material gebildet, um die Anschlußfläche 20 nach oben herauszuführen.

Um den Basis-Chip 10 mit dem Top-Chip 16 zu verdrahten, ist ferner eine Metallisierung 30 vorgesehen, die sich von dem mit elektrisch leitfähigem Material gefüllten Durchgangsloch 26a bis zu dem mit elektrisch leitfähigem Material gefüllten Durchgangsloch 28 erstreckt.

Für den Fall des mit elektrisch leitfähigem Material gefüllten Durchgangslochs 26b, das lediglich zur Kontaktierung des Basis-Chips 10 vorgesehen ist, ist eine Anschlußfläche für eine Kontaktierung in dem in **Fig. 1** gezeigten Querschnitt nicht eingezeichnet.

Bei dem in **Fig. 1** gezeigten Ausführungsbeispiel ist zu sehen, daß es nicht unbedingt erforderlich ist, daß der Top-Chip 16 vollständig in die Planarisierungsschicht 24 eingebettet ist, sondern daß sich die Metallisierung 30 im Falle einer bündigen Planarisierungsschicht auch direkt bis zu der Anschlußfläche 20 des Top-Chips 16 erstrecken könnte.

Fig. 2 zeigt ein Multi-Chip-Modul gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung, das nicht für eine Bond-Kontaktierung der Metallisierung 30 vorgesehen ist, sondern das eine Kontaktstruktur hat, die für eine Flip-Chip-Montage angepaßt ist. Hierzu ist ein weiterer Metallisierungsbereich 32 vorgesehen, der einerseits mit der Metallisierung 30, die die Durchgangslöcher 26a und 28 verbindet, elektrisch leitfähig verbunden ist, und der andererseits unter einem ebenfalls mit elektrisch leitfähigem Material gefüllten Durchgangsloch durch eine Isolationsschicht 36 mündet. Auf den mit elektrisch leitfähigem Material gefüllten weiteren Durchgangslöchern 34 sind dann für eine Flip-Chip-Montage Lotkugeln 38 angeordnet. Ansonsten unterscheidet sich das Multi-Chip-Modul gemäß dem in **Fig. 2** gezeigten Ausführungsbeispiel nicht von dem in **Fig. 1** gezeigten Multi-Chip-Modul.

Anhand des in **Fig. 2** gezeigten weiteren Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung wird deutlich, daß ein erfindungsgemäßes Multi-Chip-Modul beim Unterbringen in ein Gehäuse bzw. beim Kontaktieren mit äußeren Anschlußflächen ganz genauso wie Einzel-ICs behandelt werden kann. Letztendlich ist auch die Höhe des gesamten Multi-Chip-Moduls aufgrund des sehr dünnen Top-Chips nicht wesentlich größer als die Höhe eines üblichen Einzel-IC. Hier sei darauf hingewiesen, daß die **Fig. 1** und **2** bezüglich der Dicken des Basis-Chips und des Top-Chips nicht maßstabsgetreu gezeichnet sind. In der Tat haben übliche Basis-Chips eine Dicke von 680 bis 800 µm, während für den Top-Chip eine Dicke von etwa 20 µm bevorzugt wird. Dies bedeutet, daß die Dicke des Basis-Chips in der Tat etwa 35 mal so groß ist wie die Dicke des Top-Chips.

Ein Metallisierungsschema kann auch durch einen CSP-Prozeß (CSP = Chip Size Package) unter Verwendung einer lötbaren Metallschicht und einer Aufbringung von Löthöckern oder "Löt-Bumps" erzeugt werden.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf einen Basiswafer 40, der durch eine Mehrzahl von Basis-Chips 10 gebildet sind. **Fig. 3** zeigt also eine Mehrzahl von Multi-Chip-Modulen vor ihrer Vereinzelung in einzelne Multi-Chip-Module. Aus Übersichtlichkeitsgründen ist jedoch in **Fig. 3** lediglich ein einziges Multi-Chip-Modul gezeigt, wobei jedoch in den zu dem Basis-Chip 10 benachbarten Sektoren beliebige weitere Multi-Chip-Module vorhanden sein werden.

Fig. 3 zeigt ferner ein Multi-Chip-Modul, bei dem nicht nur ein Top-Chip vorhanden sind, sondern zwei Top-Chips. Die beiden Top-Chips sind über Inter-Chip-Kontaktstrukturen 42 miteinander verbunden. Der Top-Chip 1 ist ferner über eine Kontaktstruktur 30 mit Anschlußflächen 14 des Basis-Chips verbunden. Ferner ist in **Fig. 3** anhand der Verdrahtungen 44 der Fall gezeigt, bei dem eine Anschlußfläche 14 des Basis-Chips direkt mit einer äußeren Anschlußfläche 46 des Multi-Chip-Moduls verbunden ist. Die Kontaktstruktur 44 von **Fig. 3** umfaßt somit das weitere Durchgangsloch 26b von **Fig. 1** sowie eine Metallisierung, die in **Fig. 1** nicht dargestellt ist.

Im nachfolgenden wird auf die Herstellung der in **Fig. 1** und **Fig. 2** dargestellten erfindungsgemäßen MCM-Module eingegangen.

Das erfindungsgemäße Integrationskonzept macht sich die Verwendung von extrem dünnen Schaltungsschips zu nutze, deren Restdicke bis zu 5 µm betragen kann. Mehrerer dieser extrem flachen Schaltungsschips werden auf einem Basis-Wafer, wie z. B. dem Wafer 40 von **Fig. 3**, aufgeklebt. Die Klebeschicht 22 kann durch ein Spin-Coating-Verfahren sehr niedrig gehalten werden. Eine Kleberdicke von 3 µm kann bereits als ausreichend angesehen werden.

Vorzugsweise umfaßt ein Basis-Wafer 40, wie es ebenfalls in **Fig. 3** gezeigt ist, eine Mehrzahl von Basis-Chips 10.

Der mit den dünnen Top-Chips 16 bestückte Basis-Wafer wird nun vorzugsweise mit einem Polymermaterial, wie z. B. Polyimid, BCB (BCB = Benzocyclobuten) oder Spin-On Glass, in einem Spin-Coating-Verfahren beschichtet. Die 5 dünnen Chips werden somit in den Polymerfilm, der die Planarisierungsschicht 24 bildet, vorzugsweise eingebettet.

Mittels eines Lithographie-Schritts und eines Standard-Ätzverfahrens werden dann die Durchgangslöcher 26a, 26b, 28 in dem Polymerfilm 24 erzeugt, welche jeweils auf den 10 Metallisierungsebenen 20, 14 des Top-Chips 16 bzw. des Basis-Chips 10 enden. Die Durchgangslöcher werden dann beispielsweise mittels stromlosem Plattieren unter Verwendung von Nickel, durch galvanisches Abscheiden oder durch ein CVD-Verfahren mit Metall aufgefüllt. Außerdem 15 wird eine ganzflächige Metallebene auf dem Wafer erzeugt, die auch als Dünnfilm-Metallisierung bezeichnet wird und vorzugsweise durch Sputtern gebildet wird.

Als Variante zum Sputtern können auch galvanisch erstellte Leiterbahnen verwendet werden, wenn eine größere 20 Leiterbahndicke als sie durch Sputtern erreichbar ist, gewünscht wird.

In zumindest einem weiteren Lithographie-Prozeß wird dann diese oberste Metallebene strukturiert, um die Metallisierungen 30 bzw. 32 zu erhalten. Selbstverständlich können 25 auch mehrere Metallisierungsebenen nacheinander gebildet werden, wenn zwischen den Metallisierungsebenen entsprechende Isolationsschichten 36 aufgebracht werden. Die Metallisierung 30 dient somit als Verdrahtungslage für die elektrischen Verbindungen zwischen den Chips, dem Basischip und den Kontakten des Multi-Chip-Moduls, die in **Fig. 3** als 30 ausgefüllte Vierecke dargestellt sind und mit dem Bezugszeichen 46 bezeichnet sind.

Durch die Verwendung der flachen Top-Chips 16 unterscheidet sich das fertige Multi-Chip-Modul von der äußeren Form her nicht von einem einzelnen Standard-IC mit einem einzigen Chip. Deshalb kann die elektrische Kontaktierung des MCM-Moduls mit externen Schaltungen und Bauteilen, wie z. B. einer Leiterplatte, mit jeder Standard-Verbindungstechnik erfolgen, wie z. B. durch Drahtboden im Falle von **Fig. 1** oder durch eine Flip-Chip-Montage im Falle von **Fig. 2**.

Den größten Nutzen im Hinblick auf die Minimierung der Gehäuseform und des Volumens des Chip-Systems wird 45 durch einen Flip-Chip-Montageprozeß erreicht. Hierzu wird, wie es in **Fig. 2** gezeigt ist, die Dünnfilmmetallisierungsebene 30 zur Umverdrahtung der elektrischen Kontakte verwendet. Durch die Umverdrahtung werden die normalerweise am Chiprand liegenden Kontakte über die gesamte Chip-Fläche verteilt. Die derart verteilten Anschlußflächen dienen nun als elektrische Kontakte für die Flip-Chip-Montage, nachdem die Lotkugeln 38 auf dieselben 50 aufgebracht sind.

Im nachfolgenden wird auf einige Möglichkeiten zum Herstellen von Schaltungs-Chips eingegangen, deren Dicke kleiner als 100 µm ist, und deren Dicke bevorzugterweise im Bereich von 5 bis 40 µm liegt.

Um einen Schaltungs-Wafer mit einer Standarddicke von 60 etwa 700 µm auf eine angestrebte Dicke von 5 bis 40 µm dünnen zu können, muß der Ausgangs-Wafer erst mit seiner aktiven Vorderseite auf ein Trägersubstrat, der ebenfalls ein Wafer aus Glas oder Silizium ist, geklebt werden. Wichtigste Voraussetzungen für diese Klebetechnik sind vollflächige lunkerfreie Verbindungen und eine Wiederlösbarkeit des Trägersubstrats. Als Materialien können Thermoplastmaterialien, d. h. Schmelzkleber, oder Klebefolien eingesetzt werden. Es wird derzeit bevorzugt, eine beidseitig hafende Klebefolie zu verwenden, die auf einer Seite eine spezielle Beschichtung hat, die nach einer Erwärmung auf eine 65

Temperatur zwischen 90 und 140°C ihre Haftkraft verliert. Eine andere Möglichkeit besteht in der Verwendung von Klebefolien, die nach Bestrahlung mit UV-Licht ihre Haftkraft verlieren. Hierbei müssen Glaswafer als Trägersubstrate verwendet werden.

Nach dem Aufkleben des Schaltungswafers auf den Träger wird der Schaltungswafer von der Rückseite her gedünnt. Standardverfahren hierfür sind das Abschleifen oder das naßchemische Ätzen. Eine spezielle Variante des Dünnaätzens ist das Spin-Ätzen, bei dem der Wafer auf einem rotierenden Teller liegt, während von oben das Ätzmedium auf die Scheibe fließt und von dort abgeschleudert wird. Insbesondere durch die Kombination aus Schleifen und Ätzen können die Wafer bei Verwendung eines Trägersubstrats bis auf wenige Mikrometer Restdicke gedünnt werden.

Neben der Waferdünnung muß auch das Vereinzeln der dünnen Wafer in Chips gewährleistet sein. Ein Vereinzelungs-Verfahren ist das Sägen des dünnen Wafers, solange er noch auf dem Trägersubstrat fixiert ist. Sägt man durch den dünnen Wafer bis zur Klebeschicht, können die einzelnen dünnen Chips nach Überschreiten der Ablösebedingung von der Klebefolie abgenommen werden. Alternativ kann auch der dünne Wafer mitsamt dem Trägerwafer in Chips vereinzelt werden. Bei dieser Variante wird der dünne Chip mit dem Trägerchip plaziert und aufgeklebt. Der Trägerchip wird erst anschließend abgelöst.

Um Schaltungs-Chips zu erhalten, die mechanisch möglichst integer sind, was zur Verringerung der Ausbeute bei den hier verwendeten Dicken für die Top-Chips von Vorteil ist, kann ein Wafer, der vorprozessierte Top-Chips aufweist, auf der Oberseite beispielsweise durch Sägen oder durch Trockenätzen mit Gräben versehen werden. Nach dem Aufkleben dieses mit Gräben versehenen Wafers auf einer Klebefolie wird dann die Rückseite bis zu einem bestimmten Punkt naßchemisch geätzt, wonach das wesentlich schonendere aber auch langsamer dauernde Trockenätzen eingesetzt wird, um von der Rückseite her diesen Wafer so weit zu ätzen, bis die Gräben erreicht sind, wodurch eine chemische Vereinzelung des Wafers erreicht worden ist, um die einzelnen Top-Chips 16 zu erhalten. Falls auch die Gräben mittels Trockenätzen gebildet worden sind, haben die Top-Chips keine mechanischen Beschädigungen an ihren Kanten und können somit mit hoher Ausbeute hergestellt werden, um dann auf den Basis-Chips aufgeklebt zu werden.

Aus dem vorstehenden wird ersichtlich, daß das erfundengemäße Konzept sich besonders gut für Second-Source-Anforderungen eignet, da im Falle des Austausches eines einzelnen Chips des Multi-Chip-Moduls einfach ein Wafer mit anderen Chips entsprechender Funktionalität von einem anderen Lieferanten verwendet werden kann, der dann gedünnt wird, um die einzelnen Top-Chips zu erhalten. Erst dann wird wieder unter Verwendung üblicher lithographischer Oberflächenbearbeitungstechniken nach dem Aufkleben derselben und dem Aufbringen der Planarisierungsschicht die Verdrahtung für eine neue Einzel-Chip-Komponente angepaßt. Keine Veränderungen an anderen Basis-Chips oder Top-Chips sind nötig.

Erfundengemäße Multi-Chip-Module können als elektronische Bauteile und Systeme, welche einen extrem geringen Volumenbedarf erfordern, eingesetzt werden, wie z. B. bei mobilen tragbaren Telekommunikationssystemen oder medizinischen Überwachungs- und Hilfssystemen, welche beispielsweise Hörgeräte, Herzschrittmacher oder am Körper getragene Überwachungs- und Diagnosegeräte umfassen können. Ein weiterer Anwendungsbereich sind elektronische Bauteile, die für die elektrische Signalübertragung optimiert sind, wie z. B. Hochfrequenzbauelemente. Der besondere Nutzen bei der Verwendung der erfundengemäße

MCM-Module ergibt sich insbesondere dadurch, daß auf Bonddrähte verzichtet werden kann, so daß die Verdrahtungslängen zwischen den verschiedenen Chips minimiert sind, und daß bei konsequenter Anwendung überhaupt keine Bonddrähte benötigt werden. Die elektrischen Verbindungswege können ferner in hochfrequenztauglichem Design, was die Leiterbreite und Leiterdicke anbetrifft, erstellt und gefertigt werden.

Das erfundengemäße MCM-Konzept ist schließlich auch dahingehend flexibel, daß Einzelkomponenten aus unterschiedlichen Grundmaterialien, wie z. B. Si, GaAs, InP, Quarz, usw., verwendet werden können, und daß auch Chips aus unterschiedlichen Fertigungstechnologien zusammengesetzt werden können. Dies ist z. B. der Fall bei Systemen aus Speicher-Chips, Logik-Chips, Sensorbauelementen, Chipkarten-Chips, Leistungsbauelementen oder Hochfrequenzübertragungsschips (Transponder). Jedes Einzelement kann in der für dasselbe kostengünstigsten Weise produziert werden, z. B. auch unter Verwendung unterschiedlicher Waferdurchmesser, wobei die volle Funktionalität erst im System des Multi-Chip-Moduls erreicht wird.

Patentansprüche

1. Multi-Chip-Modul mit folgenden Merkmalen:
einem Basis-Chip (10), der auf einer Oberfläche eine Passivierungsschicht (12) und zumindest eine Anschlußfläche (14) aufweist;
einem Top-Chip mit einer Oberseite und einer Unterseite, wobei der Top-Chip (16) auf seiner Oberseite eine Passivierungsschicht (18) und zumindest eine Anschlußfläche (20) aufweist, und wobei die Dicke des Top-Chips kleiner als 100 µm ist;

einer Klebeschicht (22), die zwischen der Passivierungsschicht (12) des Basis-Chips (10) und der Unterseite des Top-Chips (16) angeordnet ist und den Top-Chip (16) und den Basis-Chip (10) mechanisch verbindet;
einer elektrisch isolierenden Planarisierungsschicht (24), die auf der Oberfläche des Basis-Chips (10) aufgebracht ist, und in der der Top-Chip (16) im wesentlichen eingebettet ist;

ein mit einem elektrisch leitfähigen Material gefülltes Durchgangsloch (26a) durch die Planarisierungsschicht (24), wobei das elektrisch leitfähige Material mit der Anschlußfläche (14) des Basis-Chips (10) in elektrisch leitfähiger Verbindung ist; und

einer Kontaktstruktur (28, 30) zum Verbinden des elektrisch leitfähigen Materials in dem Durchgangsloch (26a) mit der Anschlußfläche (20) des Top-Chips (16).

2. Multi-Chip-Modul nach Anspruch 1,
bei dem sich die Planarisierungsschicht (24) über die Oberfläche des Top-Chips (16) hinweg erstreckt; und
bei dem die Kontaktstruktur (28, 30) folgende Merkmale aufweist:

ein weiteres mit elektrisch leitfähigem Material gefülltes Durchgangsloch (28) durch die Planarisierungsschicht (24), wobei das elektrisch leitfähige Material mit der Anschlußfläche (20) des Top-Chips (16) elektrisch leitfähig verbunden ist; und

eine Metallisierung (30), die auf einer Oberfläche der Planarisierungsschicht (24) aufgebracht ist, die nicht in Verbindung mit der Oberfläche des Basis-Chips (10) ist, und die das eine (26a) mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllte Durchgangsloch mit dem weiteren (28) mit einem elektrisch leitfähigen Material gefüllten Durchgangsloch verbindet.

3. Multi-Chip-Modul nach Anspruch 1 oder 2, das fer-

ner folgende Merkmale aufweist:
eine Umverdrahtungsstruktur (32), die auf der Oberfläche der Planarisierungsschicht (24) aufgebracht ist, die nicht in Verbindung mit der Oberfläche des Basis-Chips (10) ist, und die mit der Kontaktstruktur (30) in elektrisch leitfähiger Verbindung ist; - - - - -
eine Isolationsschicht (36), wobei die Umverdrahtungsstruktur (32) zwischen der Isolationsschicht (36) und der Planarisierungsschicht (24) angeordnet ist; und ein mit einem elektrisch leitfähigen Material gefülltes Anschluß-Durchgangsloch (34) durch die Isolationsschicht (36) zum Kontaktieren der Kontaktstruktur (28, 30).

4. Multi-Chip-Modul nach Anspruch 3, das ferner folgendes Merkmal aufweist: ein Lotmaterial (38) auf dem mit elektrisch leitfähigem Material gefüllten Anschluß-Durchgangsloch (34) für eine Flip-Chip-Montage des Multi-Chip-Moduls auf einem Schaltungsträger.

5. Multi-Chip-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Klebeschicht (22) aus Epoxidharz ist und eine Dicke kleiner oder gleich 10 µm hat und vorzugsweise bis zu 3 µm dick ist.

6. Multi-Chip-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Planarisierungsschicht (24) aus einem Polymermaterial hergestellt ist.

7. Multi-Chip-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das ferner folgende Merkmale aufweist: eine erste Anschlußstruktur (44) zum Kontaktieren nur des Basis-Chips (10) und/oder eine zweite Anschlußstruktur (30) zum Kontaktieren lediglich des Top-Chips (16).

8. Multi-Chip-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem der Top-Chip und/oder der Basis-Chip eine CMOS-Schaltungsstruktur (16b, 10b) aufweisen.

9. Multi-Chip-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, das eine Zwischenlage aus einem dünnen Chip und einer Planarisierungsschicht zwischen dem Top-Chip und dem Basis-Chip aufweist, wobei eine Mehrzahl von weiteren Durchgangslöchern in der weiteren Planarisierungsschicht vorhanden ist, um den Chip der Zwischenlage mit dem Basischip und dem Top-Chip zu verbinden und/oder von außen zu kontaktieren.

10. Multi-Chip-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem das Material des Basis-Chips (10) zu dem Material des Top-Chips (16) unterschiedlich ist.

11. Verfahren zum Herstellen eines Multi-Chip-Moduls mit folgenden Merkmalen:

Bereitstellen eines Basis-Wafers (40) mit einem Basis-Chip (10), der an einer Oberfläche eine Passivierungsschicht (12) und zumindest eine Anschlußfläche (14) aufweist;

Bereitstellen eines Top-Chips (16) mit einer Oberseite und einer Unterseite, wobei der Top-Chip (16) an seiner Oberseite eine Passivierungsschicht (18) und zumindest eine Anschlußfläche (20) aufweist, und wobei die Dicke des Top-Chips kleiner als 100 µm ist;

Aufbringen einer Klebeschicht (22) auf die Passivierungsschicht (12) des Basis-Chips (10);

Aufsetzen des Top-Chips (16) auf die Klebeschicht (22);

Planarisieren des Basis-Chips samt aufgeklebtem Top-Chip unter Verwendung einer Planarisierungsschicht (24);

Bilden eines Durchgangslochs (26a, 26b) durch die

Planarisierungsschicht (24) zu der Anschlußfläche (14) des Basis-Chips (10);

Auffüllen des Durchgangslochs mit einem elektrisch leitfähigen Material; und

Kontaktieren des elektrisch leitfähigen Materials in dem Durchgangsloch (26a) mit der Anschlußfläche (20) des oberen Chips.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem der Schritt des Planarisierens ein Spin-Coating-Prozeß unter Verwendung eines Polymermaterials ist.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, bei dem der Schritt des Auffüllens zumindest eines der folgenden Verfahren aufweist: stromloses Plättieren, galvanisches Abscheiden oder CVD-Beschichten.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13, bei dem der Schritt des Kontaktierens folgende Merkmale aufweist:

Aufbringen einer Metallschicht auf die Planarisierungsschicht;

Strukturieren der Metallschicht unter Verwendung einer Lithographietechnik, um eine Metallisierung (30) zu erhalten.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 14, bei dem der Schritt des Bereitstellens des Top-Chips (16) folgende Teilschritte aufweist:

Bereitstellen eines vorprozessierten Standard-Wafers; Ätzen von Gräben in die Vorderseite des Wafers unter Verwendung eines Trockenätzverfahrens;

Aufbringen des Wafers auf einen Träger; Abdünnen des Wafers von der Rückseite aus unter Verwendung eines Trockenätzens, bis die Gräben erreicht sind;

Lösen eines vereinzelten Chips von dem Träger, um einen Top-Chip (16) zu erhalten.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

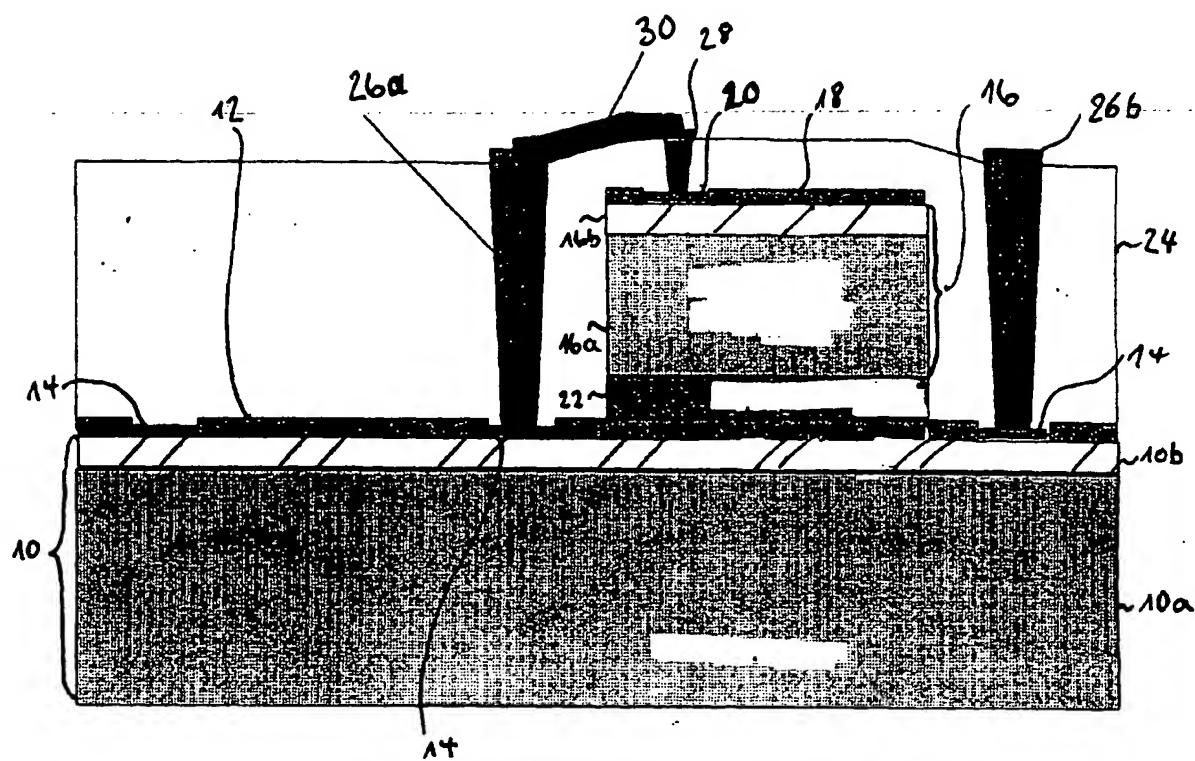


Fig. 1

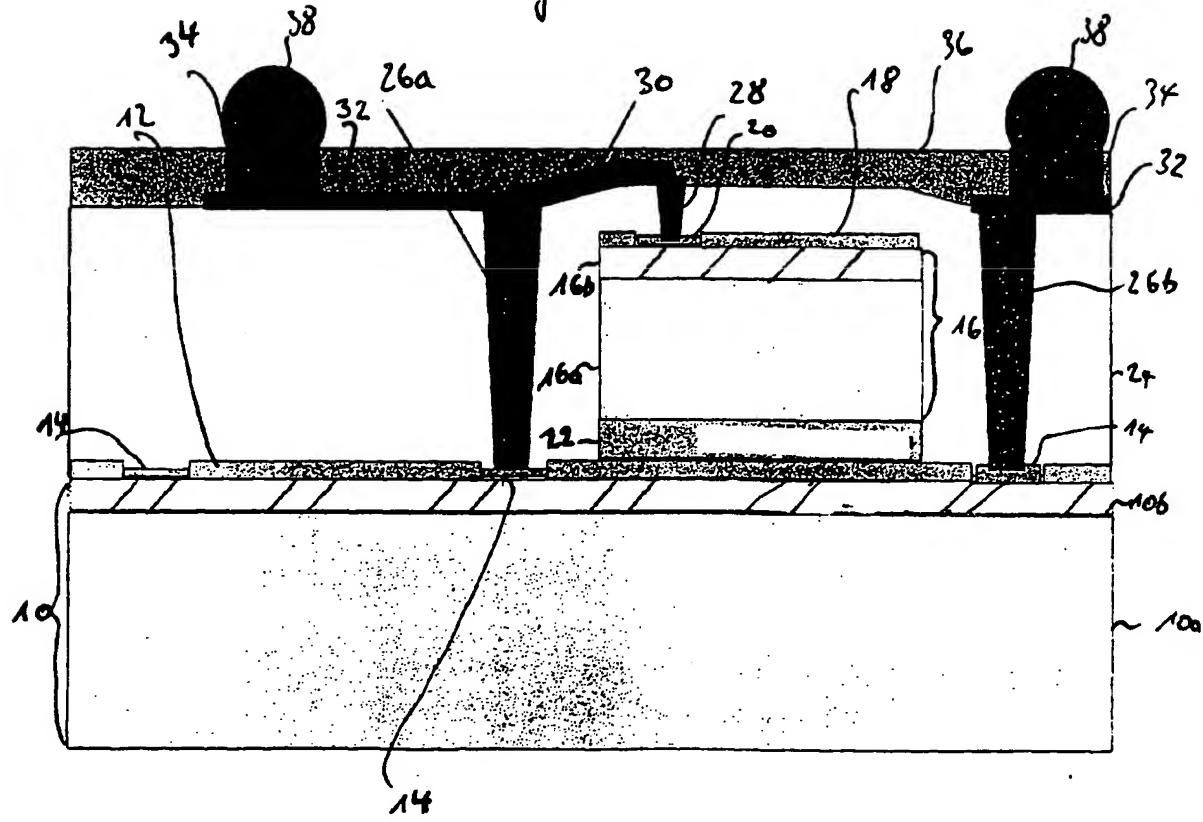


Fig. 2

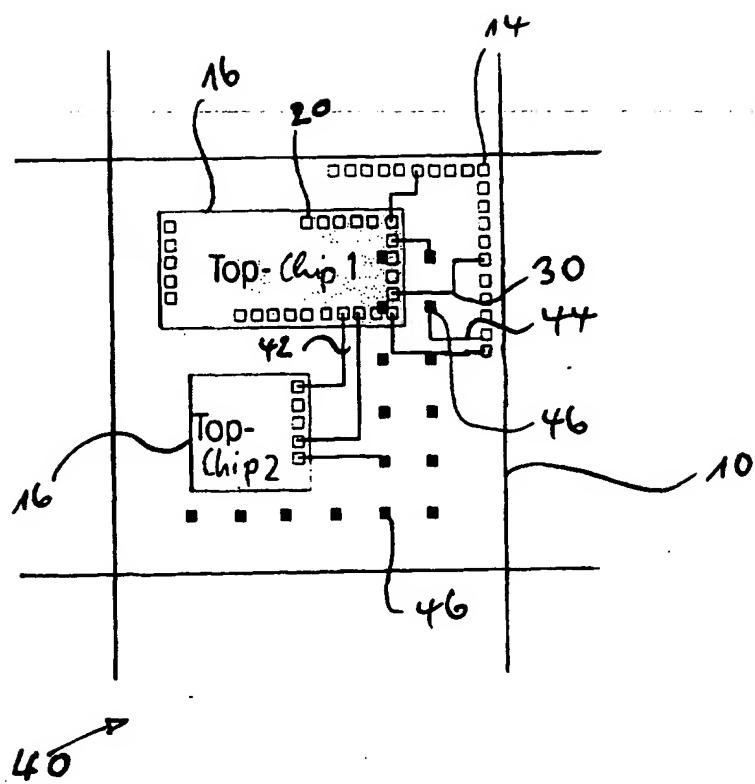


Fig. 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.